

世界最大のFRAM国際会議で富士通が “ corporate innovation award ” を受賞しました

今年4月5日から8日にかけて韓国慶州市で開催された世界最大のFRAM(強誘電体メモリ)の国際会議、第16回ISIF(The 16th International Symposium on Integrated Ferroelectrics)において、当社は“ corporate innovation award ”を受賞しました。この賞は今回の会議で新設されたもので、受賞は当社が世界で初めてFRAMを本格的に量産したことが認められたものです。

当社は、1999年から世界に先駆けてFRAMの量産を開始し、今年4月には出荷累積チップ数が1億5,000万個に達しました。富士通のFRAM技術は、常に他社をリードし、世界中から注目され続けています。



受賞式で講演
恵下 隆
LSI事業本部FRAM事業部
デバイス技術部担当部長



受賞した盾

FRAMは、不揮発性で高速な書換えが可能であり、電力消費量が小さく書換え回数が極めて大きいなどの特長をもっています。たとえば、従来の不揮発性メモリであるフラッシュメモリやEEPROMと比べて、FRAMの書換え速度は1,000倍以上、書換え回数は100,000倍以上であり、書換えのための特別な昇圧回路も必要ありません。

さらに、従来のCMOSロジック回路作製工程との整合性がよいことから、SoC(Systems on a chip)用のメモリとしても最適です。このような特長を持つFRAMは、携帯電話などのモバイル用メモリやスマートカード用メモリ、暗号情報を頻繁に書き換える必要があるセキュリティ用のメモリとしてますます発展していきます。このために次世代のFRAMでは、書換え回数無限大化、高速化、大容量化を進めていきます。



名和田 一正(左)
LSI事業本部FRAM事業部長
井上 あまね(右)
LSI事業本部FRAM事業部長代理

* FRAMは強誘電体を用いた不揮発の随時書込み可能なメモリです。
* SoCとは、複数の機能をもつ回路を1つの半導体チップのなかに組み込んだものです。当社のFRAMでは、CMOS作製工程を変更することなく、CMOSとFRAMを同一チップの中に作製することができます。